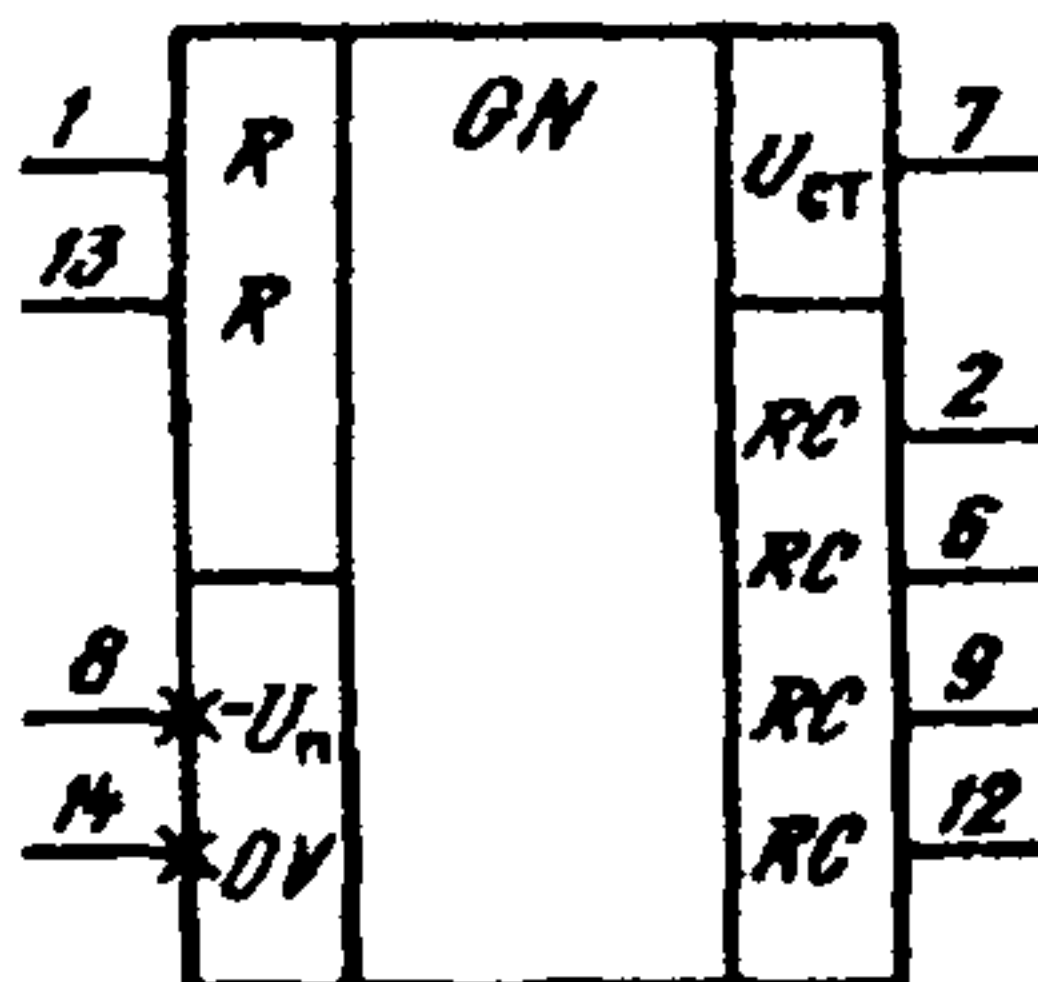


Серия К165

К165ГФ1

Микросхема представляет собой четырехфазный генератор импульсов, изготовленный по МОП-технологии. По уровням входных и выходных сигналов, совместима с микросхемами серии К145. Содержит 155 интегральных элементов. Корпус типа 301.12-1, масса не более 1,5 г



Условное графическое обозначение К165ГФ1

Назначение выводов. 1 — общий (+ U_n); 2, 3, 10 — не используются; 4 — выход стабилизатора; 5 — выход фазы $\Phi 1$, 6 — выход фазы $\Phi 2$; 7 — напряжение питания ($-U_n$); 8 — выход фазы $\Phi 4$; 9 — выход фазы $\Phi 3$; 11, 12 — регулировка частоты.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	$-27 \text{ В} \pm 5\%$
Выходное напряжение высокого уровня при $U_n = -27 \text{ В}$	$-24,6 \dots 28,4 \text{ В}$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq -1 \text{ В}$
Ток потребления при $U_n = -28,4 \text{ В}$	$\leq 8 \text{ мА}$
Частота генерирования при $U_n = -27 \text{ В}$	68. 72 кГц
Время перехода из состояния низкого уровня	

в состояние высокого уровня при $U_n = -27$ В	< 1 мкс
Время перехода из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня при $U_n = -27$ В	$< 0,6$ мкс
Время перекрытия фаз $\Phi 1$ и $\Phi 2$, $\Phi 3$ и $\Phi 4$ при $U_n = -27$ В:	
$t_{p1,2}$	$1,8$ мкс $\pm \Delta$
$t_{p1,2} \dots \dots$	$1,5$ мкс $\pm \Delta$
Время сдвига спадов импульсов фаз $\Phi 2$ и $\Phi 3$, $\Phi 3$ и $\Phi 4$ при $U_n = -27$ В:	
$t_{s1,2}$	$1,5$ мкс $\pm \Delta$
$t_{s3,4}$	$1,2$ мкс $\pm \Delta$
Интервал времени между импульсами фаз $\Phi 2$ и $\Phi 4$, $\Phi 4$ и $\Phi 2$ при $U_n = -27$ В	$> 0,1$ мкс
Уход частоты при $U_n = -28,4$ В	$< 10\%$
Емкость нагрузки по выходам фаз:	
$\Phi 1$ и $\Phi 3$	< 400 пФ
$\Phi 2$ и $\Phi 4$	< 200 пФ
Сопротивление нагрузки	> 150 кОм

Примечание: $\Delta = t_{\text{пер}}^{0,1} - 0,1 = t_{\text{пер}}^{1,0} - 0,1$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение на выводах питания и подключения внешнего резистора, задающего частоту	$-25,6. \dots -28,4$ В
Сопротивление нагрузки по выходам фаз	> 150 кОм
Температура окружающей среды	$-10 \dots +70^\circ$ С

Рекомендации по применению

При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек выводов микросхемы.

Температура пайки микросхем $275 \pm 5^\circ$ С. Расстояние от корпуса до места пайки не менее 1 мм, продолжительность пайки не более 2,5 с. Допустимое значение статического потенциала 200 В